マテリアルズ・インフォマティクスの基礎と応用

格子物性の第一原理計算

分子科学研究所
大阪大学産業科学研究所

南谷英美

今日のお品書き

前半：理論・基礎編

- ・ 格子物性の基本：フォノン

格子振動の量子？

どういう現象と関係がある？

- ・ フォノンの第一原理計算

フローズンフォノン法

密度汎関数摂動法

計算の実例

実際にどうやって計算するのか？

今日のお品書き

後半：応用・発展編

- ・フォノン計算の応用

非調和効果と熱伝導率

- ・フォノン計算と機械学習ポテンシャルの組み合わせ

機械学習ポテンシャルとは？

熱伝導率計算への応用

実例など

格子物性の基礎

第一原理計算といえば、電子状態？

コーンシャム方程式

$$n(r) = 2 \sum_{n=1}^{N/2} |\psi_n(r)|^2$$
$$H_{scf} \psi_n(r) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V_{scf}(r) \right) \psi_n(r) = \epsilon_n \psi_n(r)$$

$V_{ext} + V_{Hartree} + V_{xc}$

ヘルマン-ファイマンの定理

電子密度からの寄与 他の核からの寄与

$$F_I = - \int d^3r n(r) \frac{\partial V_{ext}(r)}{\partial R_I} - \frac{\partial E_{II}}{\partial R_I}$$

原子に働く力を量子力学ベースで求められる
→原子の振動がわかる

原子の振動

原子の運動はポテンシャルエネルギーによって決まる

原子が安定に存在する位置：ポテンシャルの極小点

安定な位置周辺のポテンシャルの形状は、
 $\sim x^2$ のような形で近似できそう

調和近似

調和振動子ポテンシャル

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

調和振動子のおさらい

最も単純に古典的な1次元調和振動子が一つある時

$$U = \frac{1}{2} kx^2 \quad F = -\frac{dU}{dx} = -kx = m\ddot{x}$$

質量
↓

$x = Ae^{i\omega t}$ の一般解を代入すると

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{古典の振動解}$$

1次元原子の鎖の場合

1つの原子が入った単位胞が繰り返されるとする

隣の原子とのみ相互作用を持ち、その相互作用の定数は K とおく

隣り合う原子の変位から生じる復元力を考えると

$$m\ddot{u}_n = K(u_{n+1} - u_n) - K(u_n - u_{n-1})$$

u_n : 平面波でかけるだろう (フーリエ変換のイメージ)

どれぐらいの周期を持つか

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{m}} u_q e^{i(q \cdot r_n - \omega t)}$$

$r_n = na$ 単位胞の基準点の座標
 a は格子定数

1次元原子の鎖の解

$$-m\omega^2 u_q e^{i(qr_n - \omega t)} = u_q K \{ e^{i(q(r_n + a) - \omega t)} + e^{i(q(r_n - a) - \omega t)} - 2e^{i(qr_n - \omega t)} \}$$

$$-m\omega^2 = K \{ e^{iqa} + e^{-iqa} - 2 \}$$

$$\omega^2 = \frac{2K}{m} \{ 1 - \cos qa \}$$

$$\omega = 2 \sqrt{\frac{K}{m}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

音響フォノン
(Acoustic phonon)

角振動数 ω は q の関数になる

有限の q : 変位が単位胞ごとにずれる

異なる質量の原子がある場合

単位胞

$$m u_{1n}'' = K(u_{2n} - u_{1n}) - K(u_{1n} - u_{2n-1})$$

$$m u_{2n}'' = K(u_{1n+1} - u_{2n}) - K(u_{2n} - u_{1n})$$

$$\begin{pmatrix} \omega^2 - \frac{2K}{m_1} & \frac{K(1 + e^{iqa})}{\sqrt{m_1 m_2}} \\ \frac{K(1 - e^{iqa})}{\sqrt{m_1 m_2}} & \omega^2 - \frac{2K}{m_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1q} \\ u_{2q} \end{pmatrix} = 0$$

$$u_{1n} = \frac{1}{\sqrt{m_1}} u_{1q} e^{i(q \cdot r_n - \omega t)}$$

$$u_{2n} = \frac{1}{\sqrt{m_2}} u_{2q} e^{i(q \cdot r_n - \omega t)}$$

異なる原子がある場合の分散関係

$$\omega^2 = K \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \pm K \sqrt{\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)^2 - \frac{4}{m_1 m_2} \sin^2 \left(\frac{qa}{2} \right)}$$

質量が異なる原子が入っていると、 $q=0$ でも0ではないモードが出てくる→光学フォノン

双極子を発生するような方向に振動
→電磁場との相互作用（なので光学フォノンという）

一般的な格子振動

ばねの方程式より一般的な取り扱い

変位でポテンシャルをテイラー展開する

最安定な平衡点→原子にかかる力は0
→テイラー展開の1次は残らない

$$U = U_0 + \frac{1}{2} \sum_{ni\alpha} \sum_{mj\beta} \frac{\partial^2 U}{\partial u_{ni}^\alpha \partial u_{mj}^\beta} u_{ni}^\alpha u_{mj}^\beta + \dots$$

3次元結晶を表現するために
m,n ユニットセルの番号
i,j: ユニットセル内の原子の番号
 $\alpha \beta$: x,y,z方向の添字

変位についての運動方程式

力定数、ヘシアン行列

$$m_{ni} \frac{d^2 u_{ni}^\alpha}{dt^2} + \sum_{mj\beta} \frac{\partial^2 U}{\partial u_{ni}^\alpha \partial u_{mj}^\beta} u_{mj}^\beta = 0$$

$\Phi_{ni,mj}^{\alpha\beta}$

u_{ni}^α による微分の結果

表記は結構バラバラだが、
ユニットセル・原子・方向
の添字を持つ

一般的な格子振動

セルの位置 + セル内の位置

$$u_{ni}^\alpha = \frac{1}{\sqrt{m_{ni}}} u_i^\alpha e^{i(q \cdot (R_n + \tau_i) - \omega t)}$$

ブロッホ波動関数になる

$$-\sqrt{m_{ni}} \omega^2 u_i^\alpha + \sum_{mj\beta} \frac{1}{\sqrt{m_{mj}}} \Phi_{ni,mj}^{\alpha\beta} u_j^\beta e^{i(q \cdot (R_m - R_n) + q \cdot (\tau_j - \tau_i))} = 0$$

質量で割ったもの：ダイナミカルマトリックス: $D_{ij}^{\alpha\beta}(R_n - R_m)$

$$-\omega^2 u_i^\alpha + \sum_{mj\beta} e^{-iq \cdot (\tau_i - \tau_j)} \frac{\Phi_{ni,mj}^{\alpha\beta}}{\sqrt{m_{mj} m_{ni}}} e^{-iq \cdot (R_n - R_m)} u_j^\beta = 0$$

そのフーリエ変換形式: $D_{ij}^{\alpha\beta}(q)$

ダイナミカルマトリックスの固有値問題に落ち着く

$$-\omega^2 u_i^\alpha + \sum_{mj\beta} D_{ij}^{\alpha\beta}(q) u_j^\beta = 0$$

音響と光学 横波と縦波

振動方向が波数の向きと平行かどうか

量子系

$$H\psi = E\psi$$

運動エネルギー

$$\frac{p^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \right)$$

ポテンシャルエネルギー

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2}\hbar\omega(a^\dagger a + aa^\dagger) \\ &= \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

- 量子系の場合、エネルギー準位は離散的になる

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

- ハミルトニアンを書き換え

$$\begin{aligned} a^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega m}} (p - im\omega x) && \text{生成演算子} \\ a &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega m}} (p + im\omega x) && \text{消滅演算子} \end{aligned}$$

$$aa^\dagger - a^\dagger a = 1 \quad \text{交換関係}$$

離散的なエネルギー準位 → “フォノン” がいくつ励起されたか

量子系

格子になった場合

変位と運動量のフーリエ変換

基準振動の固有ベクトルへの射影
(質量の補正もここで取り込まれている)

$$a_{qs}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega(qs)}} P_{qs} - i \sqrt{\frac{\omega(qs)}{2\hbar}} X_{qs}^\dagger$$

$$a_{qs} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega(qs)}} P_{qs}^\dagger + i \sqrt{\frac{\omega(qs)}{2\hbar}} X_{qs}$$

$$H = \hbar\omega(qs) \left(a_{qs}^\dagger a_{qs} + \frac{1}{2} \right)$$

波数 q ブランチ s のフォノン
エネルギー $\hbar\omega(qs)$

詳細はややこしいので割愛

フォノンバンドの例

graphene

二次元物質特有の
ZAモードの分散関係 Flexural phonon

GaN

GaN → 極性半導体
TOとLOがガンマ点で分裂 (LO-TO splitting)

フォノンバンドを計算してわかること

定積熱容量

フォノン系のエネルギー

$$E = \sum_{qv} \hbar\omega(qv) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega(qv)}{k_B T}\right) - 1} \right]$$

ゼロ点振動 + ボーズ分布

定積熱容量 (温度を上げるのに必要なエネルギー)

$$C_v = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_v$$
$$= \sum_{qv} k_B \left(\frac{\hbar\omega(qv)}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\hbar\omega(qv)}{k_B T}\right)}{\left[\exp\left(\frac{\hbar\omega(qv)}{k_B T}\right) - 1 \right]^2}$$

安定性

ダイナミカルマトリックスの対角化
→ ω が虚数解を持つことがある

停留点はあるが、安定点ではない

準安定状態・相転移近傍

この部分に対応する
変位下では不安定

電荷密度波etc...

第一原理計算フォノン計算

フローズンフォノン法

$$-\omega^2 u_i^\alpha + \sum_{mj\beta} \left[e^{-iq \cdot (\tau_i - \tau_j)} \frac{\Phi_{ni,mj}^{\alpha\beta}}{\sqrt{m_{mj} m_{ni}}} e^{-iq \cdot (R_n - R_m)} \right] u_j^\beta = 0$$

これをストレートフォワードに計算する

ただし、力に関する式に書き直す

$$\Phi_{ni,mj}^{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 U}{\partial u_{ni}^\alpha \partial u_{mj}^\beta} = -\frac{\partial F_{mj}^\beta}{\partial u_{ni}^\alpha}$$

n番目のセルの原子iを α 方向に動かしたとき、m番目のセルの原子jに β 方向にどれだけの力が生じるか？

セルの繰り返し：スーパーセル

フローズンフォノン法によるフォノン計算

フローズンフォノン法に必要なワークフロー

(前処理)

- ・スーパーセルを作る
- ・独立な変位パターンを同定
- ・必要な変位パターンが入ったインプット構造を作成

- ・それぞれのパターンを第一原理計算

(後処理)

- ・第一原理結果を解析してダイナミカルマトリックスを計算
- ・フォノンバンドetc...

Phonopyはこの前処理・後処理部分を自動化

手作業でやるのは大変...

Phonopy を使いましょう

<https://phonopy.github.io/phonopy/index.html>

第一原理計算部分は、
VASP, Quantum-Espressoなど代表的な
コードとのインターフェースがある

密度汎関数摂動理論 (DFPT)

密度汎関数理論

コーン・シャム軌道で決まる電子密度

$$n(r) = 2 \sum_{n=1}^{N/2} |\psi_n(r)|^2$$

コーン・シャム方程式

$$H_{scf} \psi_n(r) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V_{scf}(r) \right) \psi_n(r) = \epsilon_n \psi_n(r)$$

微小な原子変位のもとでどのように変化するか
→微分を考える

微分で得られる式

$$\frac{\partial n(r)}{\partial R_I} = 4 \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{N/2} \psi_n^*(r) \frac{\partial \psi_n(r)}{\partial R_I}$$

$$\frac{\partial}{\partial R_I} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V_{scf}(r) \right) \psi_n(r) = \frac{\partial}{\partial R_I} \epsilon_n \psi_n(r)$$

$$(H_{scf} - \epsilon_n) \frac{\partial \psi_n(r)}{\partial R_I} = - \left(\frac{\partial V_{scf}(r)}{\partial R_I} - \frac{\partial \epsilon_n}{\partial R_I} \right) \psi_n(r)$$

$$\frac{\partial \psi_n(r)}{\partial R_I} = \sum_{m \neq n} \frac{\psi_m(r)}{(\epsilon_n - \epsilon_m)} \left\langle \psi_m \left| \frac{\partial V_{scf}(r)}{\partial R_I} \right| \psi_n \right\rangle$$

固有値で原子の移動に依存する部分 $\rightarrow V_{scf}(r)$ の箇所
(ボルン-オッペンハイマー近似)

$$\frac{\partial \epsilon_n}{\partial R_I} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial V_{scf}(r)}{\partial R_I} \right| \psi_n \right\rangle$$

$$\sum_m \frac{|\psi_m\rangle \langle \psi_m|}{(\epsilon_n - H_{scf})} \quad \text{で展開したときに } m=n \text{ の部分は消える}$$

1次摂動による波動関数の補正の式の形をしている
 $\rightarrow$ 密度汎関数摂動理論

セルフコンシステントな方程式

$$\frac{\partial n(r)}{\partial R_I} = 4 \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{N/2} \psi_n^*(r) \frac{\partial \psi_n(r)}{\partial R_I}$$

$$\frac{\partial \psi_n(r)}{\partial R_I} = \sum_{m \neq n} \frac{\psi_m(r)}{(\epsilon_n - \epsilon_m)} \left\langle \psi_m \left| \frac{\partial V_{scf}(r)}{\partial R_I} \right| \psi_n \right\rangle$$

$$\frac{\partial V_{scf}(r)}{\partial R_I} = \frac{\partial V_R(r)}{\partial R_I} + e^2 \int \frac{1}{|r - r'|} \frac{\partial n(r')}{\partial R_I} dr' + \int \frac{\delta v_{xc}(r)}{\delta n(r')} \frac{\partial n(r')}{\partial R_I} dr'$$

イオンからの
ポテンシャル

電子-電子間の
ハートリー相互作用

交換相関項

セルフコンシステントに計算することでポテンシャルの微分
→力定数を求めることができる

2つの計算方法のメリット・デメリット

フローズンフォノン法

DFPT法

メリット

直感的

さまざまな汎関数や補正法の下でも計算できる

任意の波数での計算が可能

電子フォノン相互作用を計算できる

デメリット

小さい波数の点を計算する場合、非常に大きいスーパーセルが必要になる

実装が複雑なので、Quantum-espressoなどで一部の汎関数や補正法と組み合わせさせて使えない場合がある

電子フォノン相互作用

格子振動（フォノン）

ポテンシャルの変形

電子波動関数の歪

DFPTと電子フォノン相互作用

DFPTで解く方程式のうち2つ

電子波動関数の歪

$$\frac{\partial \psi_n(r)}{\partial R_I} = \sum_{m \neq n} \frac{\psi_m(r)}{(\epsilon_n - \epsilon_m)} \left\langle \psi_m \left| \frac{\partial V_{scf}(r)}{\partial R_I} \right| \psi_n \right\rangle$$

ポテンシャルの変形

$$\frac{\partial V_{scf}(r)}{\partial R_I} = \frac{\partial V_R(r)}{\partial R_I} + e^2 \int \frac{1}{|r - r'|} \frac{\partial n(r')}{\partial R_I} dr' + \int \frac{\delta v_{xc}(r)}{\delta n(r')} \frac{\partial n(r')}{\partial R_I} dr'$$

DFPTによるフォノン計算で得られる情報→電子フォノン相互作用を計算できる

電子フォノン相互作用の精密計算

DFPTはすごく計算が重い...😞

最大局在化ワニエ関数(Maximally localized Wannier function) :MLWFとの組み合わせ

F. Giustino et al., Phys. Rev. B, 76, 165108 (2007)

S. Ponce et al., Comput. Phys. Commun., 209, 116 (2016)

Bloch function:

$$\psi_{nk} = \langle r | nk \rangle = u_{nk}(r) e^{ikr}$$

Wannier function:

$$w_m(r - R) = \langle r | mR \rangle = \sum_{nk} e^{-ikR} U_{nmk} \psi_{nk}$$

delocalize

suitable U
→ localize

k空間(DFPT)のサンプル数が少なくても

→ 実空間に焼き直してMLWFで局在化すれば

→ もう一回 k 空間に焼き直すときに効率的に補間を行える

電子フォノン相互作用計算の応用例

代表的な応用先：超伝導転移温度の予測、半導体の輸送特性（ボルツマン方程式）

EPW(Electron-Phonon Wannier)パッケージ+Quantum-Espressoでこれらの計算が可能

超伝導: Pb

E. R. Margine and F. Giustino Phys. Rev. B, 87, 024205(2013)

半導体移動度: Si

S. Ponce et al., Phys. Rev. B, 97, 121201 (2018)

前半のまとめ

格子振動の復習：調和振動子、生成消滅演算子とフォノン

フォノン分散の第一原理計算：フローズンフォノン法・DFPT法

電子フォノン相互作用の第一原理計算